

中信证券股份有限公司
关于上海合晶硅材料股份有限公司
2024 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 6 日至 8 月 8 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、公司出具的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金置换专项鉴证报告；

- (5) 对公司高级管理人员进行访谈；
- (6) 对公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；
- (7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；
- (8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人在对公司募集资金检查过程中发现财务人员误将募集资金专户中的发行费用 2,467.32 万元转入一般户，公司已于发现后第一时间将相关资金及利息转回募集资金专户。上述转出资金未影响募集资金的操作及使用，公司不存在变相改变募集资金使用用途的情况。保荐人提醒公司加强募集资金相关账户的内控管理，后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

除此之外，保荐人和保荐代表人未发现公司存在其他重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

1、地缘政治风险

近年来，海外对中国半导体产业发展的限制是国内企业面临的重要风险因素之一。不仅增加了国内企业获取国外优秀人才、先进技术及关键设备的难度，同时地缘经济紧张局势也可能对半导体全球供应链造成冲击。

2、宏观经济与行业周期风险

全球经济目前仍旧处于弱复苏阶段，半导体产业发展周期也在触底或磨底阶段，虽在 2024 年上半年有复苏向上的迹象，但仍旧面临需求波动、产能过剩或内卷造成企业盈利能力下降等风险。

3、业绩下滑及毛利率波动风险

报告期公司的营业收入为 54,230.47 万元，公司扣除非经常性损益后归属于

母公司股东净利润为 4,163.28 万元。公司营业收入同比减少 22.93%，扣非归母净利润同比减少 66.88%，主要系全球宏观经济环境低迷、半导体产业景气度下行、公司销货数量及单价的降低导致营业收入下滑，以及产能利用率下降导致的单位成本上升以及毛利率下降。

公司外延片业务的主要应用领域为汽车及工业、通讯及办公，近期以汽车及工业、通讯及办公领域为代表的部分下游市场行业景气度出现周期性下滑。公司预计上述市场需求低迷总体属于半导体行业发展过程中的短期性波动，长期来看，随着宏观经济逐渐回暖，汽车及工业、通讯及办公等下游市场需求逐步复苏，半导体行业将逐步走出下行周期，长期呈增长态势。公司产品需求与宏观经济及半导体行业景气度密切相关，若未来宏观经济形势或半导体行业景气度发生较大波动，或者行业竞争加剧，或者汽车及工业、通讯及办公等领域下游市场需求持续减少，公司上市当年经营业绩将存在下滑 50% 的风险。若上述因素出现极端不利变化，则公司上市当年存在亏损的风险。此外，未来如果半导体行业整体情况发生重大不利变化、汽车及工业、通讯及办公等领域下游客户需求减弱、主要原材料价格大幅上涨、产能扩张导致折旧费用大幅增加，以及其他重大不利情况发生，可能导致公司在未来一定时期内面临毛利率波动的风险。

4、税收优惠风险

报告期内，公司主要全资子公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。若未来国家相关税收优惠政策发生变化，或公司主要子公司无法继续取得高新技术企业资质，则可能导致公司无法继续享受高新技术企业所得税的税收优惠政策，对公司的经营业绩产生不利影响。

5、存货跌价风险

报告期期末，公司存货账面净额为 32,823.57 万元，占流动资产比例为 14.22%。公司存货由原材料、自制半成品、库存商品、在产品、周转材料、委托加工物资构成。报告期期末，公司存货跌价准备金额为 2,145.21 万元。若未来半导体硅外延片市场景气度进一步下降、市场价格下跌，则公司可能面临存货跌价的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

6、汇率波动风险

报告期内，公司部分半导体硅外延片产品销往境外，同时部分原材料和生产设备从境外采购，上述交易主要使用美元等外币交易，导致因汇率波动产生的汇兑损益。报告期及去年同期，公司汇兑损益分别为-783.57万元以及-642.02万元，对公司业绩影响较小。但若未来人民币兑美元等外币汇率波动幅度扩大，可能导致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司财务状况。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	54,230.47	70,369.69	-22.93
归属于上市公司股东的净利润	4,820.95	13,061.94	-63.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,163.28	12,570.06	-66.88
经营活动产生的现金流量净额	16,950.32	21,425.43	-20.89
主要会计数据	2024年6月末	2023年12月末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	404,480.57	278,881.78	45.04
总资产	492,494.14	367,344.18	34.07
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.22	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.21	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	1.29	4.92	减少3.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.11	4.73	减少3.62个百分点

(%)			
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.57	8.77	减少0.20个百分点

公司 2024 上半年实现营业收入 54,230.47 万元，同比下降 22.93%，主要受到半导体市场景气下滑而影响终端需求造成出货数量减少以及产品价格下滑所致。公司实现归属于母公司所有者的净利润 4,820.95 万元，同比下降 63.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 4,163.28 万元，同比下降 66.88%，主要系受到半导体市场景气下滑，毛利下滑所致。经营活动产生的现金流量净额 16,950.32 万元，同比下降 20.89%，主要系收入下滑所致。

公司 2024 年第二季度经营业绩已较第一季度有所改善，收入第二季度较第一季度环比增加 17.73%，归属于母公司所有者的净利润第二季度较第一季度环比增加 63.92%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润第二季度较第一季度环比增加 68.57%。

归属于上市公司股东的净资产和总资产较去年同期大幅度增加,主要原因系公司今年上半年上市成功后取得募集资金净额约 14 亿元。

基本每股收益和稀释每股收益同比分别减少 63.64% 及 68.18%，主要原因系今年第一季度受半导体行业景气度下行的持续影响，销货数量及单价的降低导致营业收入下滑，以及产能利用率不佳造成的成本上升，虽然第二季度产销量有所回升,但累积上半年毛利及营业利润仍较去年同期有所减少。

扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 66.67%，主要原因系本期净利衰退。

加权平均净资产收益率同比减少 3.63 个百分点，主要原因系本期净利衰退。

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 3.62 个百分点，主要原因系本期净利衰退。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 公司的核心竞争力

1、公司掌握外延片全流程生产的核心技术，产品多项关键技术指标处于国

际先进水平

公司掌握晶体成长、衬底成型、外延生长等外延片全流程生产技术，具有相关研发技术专利并掌握核心工艺和使用知识。凭借在各个制程环节的丰富生产经验及在生产全流程的精细化质量控制能力，公司的外延片在电阻率片内均匀性、外延层厚度片内均匀性、表面颗粒等关键技术指标均处于国际先进水平。公司还掌握了高难度的定制化外延工艺，工艺水平已达到国际一线半导体芯片制造商的要求，受到了客户的高度认可。

经过多年的技术创新与积累，截至报告期末，公司拥有各种专利及软件著作权共计 207 项。公司先后参与制定多个国家及地方标准，被评为国家级专精特新“小巨人”企业、“上海市科技小巨人企业”、上海市及郑州市认定的“专精特新”中小企业、河南省工业技术研发中心、中国电子材料行业协会半导体材料分会副理事长单位等。

2、公司是我国少数具备外延片全流程生产能力的制造厂商，能够发挥一体化优势，提升产品品质并满足客户需求

外延片的生产主要可分为晶体成长、衬底成型及外延生长三个工艺环节，任一环节的技术和工艺水平均对外延片的质量有着至关重要的影响。公司是中国少数具备晶体成长、衬底成型及外延生长的外延片一体化生产能力的企业。

公司的一体化生产能力具有众多优势。首先，外延片是在衬底片上进行外延生长得到，因此衬底片的质量对外延片的质量有着重要的影响。通过采取一体化生产模式，公司对衬底片的质量具有更强的把控能力，从而增强外延片整体质量稳定性。其次，下游客户对定制化外延片的需求日益增长，而定制化外延片的研发与生产需从晶体成长和衬底成型阶段即开始对工艺细节进行精准控制。通过采取一体化生产模式，公司可更好完成定制化产品的生产，满足客户的定制化需求。因此，凭借一体化生产模式，公司能够大幅提升产品品质并满足客户需求，有效提高公司竞争力。

3、公司凭借严格的生产管理体系，拥有稳定的产品质量控制能力

公司拥有一套集智能制造、精准控制、实时监测为一体的生产管理体系，能

在较好地满足自动化生产、信息互联、定制服务等需求的同时，拥有突出的规模制造能力。

(1) 智能制造：公司使用 SAP 系统针对物料进行系统化管理，通过符合自身产品设计的 MES 生产管理系统实现智能生产和智能排产。一方面，智能生产确保工艺流程稳定，大幅提高了各环节的生产效率，保证了产线的高效运行；另一方面，智能排产在保证产品高质量的情况下，能够灵活为客户提供定制化产品服务，能够快速响应各类客户订单需求。

(2) 精准控制：公司能够精准控制各关键工序，能够收集单个产品的全质量参数，从而实现产品制造过程的精准质量监测与全生命周期的质量追溯。公司已通过 ISO9001、IATF16949 质量管理体系认证，在生产中严格按照质量管理体系进行质量控制和管理，从进料收货、产品制造、成品入库至出货检测，均实施了完善的管控计划，并应用 SPC 进行品质管控，以力争达到产品零缺陷的目标。

(3) 实时监测：公司自主开发了 FDC 系统（实时故障检测与分类系统），对于产品的品质由事后检验变为事中控制，能够自动推送实时制造状态信息，及时反馈生产不良率情况。公司通过对生产过程、产品参数施行全流程严格监控，确保了交付给客户产品的一致性、稳定性和可靠性。同时公司与主要客户实现了生产数据即时共享，可以将产品生产时间、出货时间等信息及时传递给客户。

4、公司产品通过众多国内外一线半导体厂商认证，已实现长期批量供货并取得客户广泛认可

半导体器件制造企业对外延片的质量有严苛的要求，对供应商的选择也非常慎重。下游芯片制造企业等客户在引入新的外延片供应商时，通常会进行严格的供应商认证。由于客户的认证周期较长，一旦公司的产品被认证通过，公司将更容易与客户建立长期、稳固的合作关系。

(二) 核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出变化

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	4,647.77	6,173.10	-24.71
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	4,647.77	6,173.10	-24.71
研发投入总额占营业收入比例(%)	8.57	8.77	减少0.20个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	不适用

2024年1-6月，公司专注于外延片全流程的技术研发，2024年1-6月公司研发投入4,647.77万元，占营业收入8.57%，研发投入一直保持在较高水平。

(二) 研发进展

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	水平炉长厚 POLY 技术研究	280.00	16.15	274.99	量产阶段	15000Å POLY 良率≥99%	国内先进水平	应用于功率器件品质提升
2	树脂砂轮倒角工艺的研究	140.00	37.00	37.00	小批量实验测试	1、主要技术指标: 粗糙度 ≤0.1umSlip≤10mm 2、主要经济指标: 改善倒角品质, 提升市场竞争力	国内先进水平	重要原辅料国产化
3	硅片背封白边缺陷改善技术的研发	140.00	42.09	42.09	小批量实验测试	1、主要技术指标: 无白边 2、主要经济指标: MUFFLE 使用寿命增加一倍, 成本降低 50%	国内先进水平	应用于功率器件品质提升
4	超重掺 B 抛光面边缘点缺陷改善的研究	130.00	34.27	34.27	小批量实验测试	超重掺硼抛光片边缘点缺陷发生率从 5%降低至 2%以下	国内先进水平	应用于功率器件品质提升
5	8 Inch 重掺砷低阻单晶开发	98.00	83.40	83.40	长晶工艺测试调整阶段	降低 8Inch 重掺砷单晶阻值	国内先进水平	直拉单晶硅的生长技术
6	8 Inch 重掺硼单晶工艺开发	112.00	70.19	70.19	产品客户端验证阶段	建立 8Inch 重掺硼单晶长晶能力	国内先进水平	直拉单晶硅的生长技术

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
7	300mm 外延温度控制优化	532.97	12.26	513.78	已完成	通过 PID 等参数设定	国内先进水平	CIS 器件用 12 吋外延片、功率器件用 12 吋外延片
8	300mm 外延炉机台备件国产化开发	572.48	11.30	534.83	已有合格供应商	通过石墨件国产化达到降低成本	国内先进水平	国产化备件全面应用到 12 寸外延炉，有效避免断料发生
9	300mm 外延片 37nm 颗粒清洗能力研发	477.60	10.23	441.88	完成工艺验证并进入生产线送样验证阶段	提高清洗机台清洗能力，达到 37nm 颗粒制程能力	国内先进水平	用于 IGBT, P/P 和一般 300mm 外延片中
10	300mm 全自动目检机开发	512.09	11.09	478.65	量产阶段	减少人为因素造成的产品报废，提高良率及品质	国内先进水平	应用于大硅片外观检查
11	300mm P/P 外延片工艺研发	513.47	12.42	478.62	已完成	通过温度/生长速率/气流配比控制 ADE 参数	国内领先	大规模集成电路
12	ASM E2000 外延炉备件国产化开发	2,150.16	12.50	1,451.58	已有合格供应商	开发国产化替代备件，降低运行成本，降低备件断料风险	国内领先	国产化备件全面应用到 ASM E2000 外延炉，有效避免断料发生
13	多层外延技术研发	1,963.26	11.72	1,316.84	量产阶段	改善多层外延能力	国内领先	应用于制造高压超结 Super Junction 器件的衬底，多层外延可改善器件电性。
14	LPE 3061 外延炉备件国产化	1,947.35	13.04	1,338.27	已完成	备件国产化，降低断料风险，降低成本	国内领先	国产化备件全面应用到 LPE 3061 外延炉，有效避免断料发

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	开发							生
15	12英寸车规级850V以上IGBT超厚外延片研发	1,105.38	319.55	319.55	工艺参数调整测试阶段	开发出新能源汽车行业关键基础材料车规级IGBT用12英寸高压厚膜外延片	国内先进水平	用于车规级850V以上的IGBT功率器件
16	12英寸45-60nm级先进工艺BCD外延片研发	1,159.30	327.80	327.80	产品调试	BCD用外延片产品研发及良率提升	国内先进水平	BCD器件，电源管理模拟芯片
17	12英寸CIS用外延研发	1,435.65	381.66	381.66	工艺参数调整测试阶段	送样生产，厚度/阻值/Flatness/Particle/BMD/Lifetime/等参数达到客户要求的BSL	国内领先	应用于手机，安防，监控，医疗，工业上的摄像头
18	8英寸高品质外延片清洗工艺开发	909.92	484.25	484.25	DOE设计&工艺试验	颗粒($\geq 0.12\mu\text{m}$) $\leq 20\text{ppw}$, 芯片表面金属沾污水平(Cu, Fe, Cr, Ni, Zn) $\leq 1\text{E}8\text{atom/cm}^3$, 表面轻金属沾污水平(Na, K, Ca, Al) $\leq 5\text{E}8\text{atom/cm}^3$	国内领先	提高200mm硅外延片的良率
19	8英寸超厚外延工艺研发	842.52	615.80	615.80	外延蚀刻工艺优化	良率达到95%成本节约3%	国内先进	应用于IGBT器件，可大量用于新能源车与充电桩，有广阔的市场前景

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
20	8英寸ASM多层外延工艺研发	1,287.37	619.20	619.20	外延工艺优化及验证	改善多层外延能力	国内领先	ASM2000/ASM2000PLUS/ASM2500等机型上有效缩短EPI时间提升机台产能
21	直径300mm抛光后硅片表面缺陷控制工艺技术研究	808.00	143.66	446.42	工艺参数优化调整,工艺参数验证阶段	完善12英寸抛光片表面缺陷控制工艺	达到国内先进水平	集成电路硅片表面质量改善
22	直径200mm硅抛光片背面缺陷控制工艺技术研究	460.00	152.08	455.46	抛光工艺参数调整测试阶段	降低硅片背面刮伤率	达到国内先进水平	集成电路硅片表面质量改善
23	直径200/300mm重掺晶圆Ring etching技术的研究	1,365.00	20.47	155.01	产品小规模生产测试阶段	实现边缘蚀刻精度精准控制,提高产品良率	达到国际先进水平	芯片制造过程中晶圆表面清洗、刻蚀及表面定性等工艺及半导体制造过程的ESH问题
24	直径200mm硅片研磨污染控制新工艺及装置研发	440.00	29.10	270.82	工艺参数调整测试阶段	提高产品的洁净度水平	达到国内先进水平	集成电路硅片表面质量改善
25	直径200mm	812.00	73.13	265.46	抛光工	提高产品的平坦度	达到国内先进水	集成电路平坦度改善

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	抛光布形状控制新技术及装置研究				艺参数调整测试阶段		平	
26	一种侦测200mm晶圆盒变形的研发装置研究	400.00	22.86	237.47	工艺参数调整测试阶段	提高产品的平坦度、降低缺陷度	达到国内先进水平	集成电路平坦度改善
27	直径300mm轻掺低氧单晶硅棒工艺研发	469.00	217.50	217.50	工艺参数调整测试阶段	控制硅片中心氧含量水平	达到国内先进水平	直拉单晶硅的生长技术
28	直径300mm P型外延一体化单晶硅棒新工艺研发	1,000.00	133.27	133.27	工艺参数调整测试阶段	大尺寸 P/P-单晶硅生长工艺开发	达到国内先进水平	直拉单晶硅的生长技术
29	直径300mm硅片 Edge Surface Metal 控制工艺技术研究	480.00	92.11	92.11	工艺参数调整测试阶段	研发新型的清洗技术，去除硅片边缘的金属杂质	达到国内先进水平	集成电路硅片表面质量改善
30	直径200mm硅片表面颗粒控制抛光技术	480.00	68.23	68.23	工艺参数调整测试阶段	减少或消除硅片表面颗粒的产生	达到国内先进水平	集成电路硅片表面质量改善

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	研究				段			
31	直径 200mm 超重掺硼抛光后硅片表面刮伤缺陷控制工艺技术研究	480.00	68.12	68.12	工艺参数调整测试阶段	降低表面缺陷 Reject rate, 减少硅片损伤	达到国内先进水平	集成电路硅片表面质量改善
32	直径 300mm 硅抛光片平坦度控制工艺技术研究	520.00	110.15	110.15	不同抛光垫调整测试阶段	研究大尺寸轻掺 P/P-抛光硅片的制备工艺	达到国内先进水平	集成电路平坦度改善
33	高浓度 N 型掺质晶棒工艺研发	600.00	67.01	67.01	工艺参数调整测试阶段	重掺单晶硅棒工艺研发	达到国内先进水平	直拉单晶硅的生长技术
34	直径 300mm 超薄片抛光工艺技术研究	480.00	102.65	102.65	不同抛光垫调整测试阶段	大尺寸超薄片抛光工艺技术开发	达到国内先进水平	直拉单晶硅的生长技术
	其他本期投入金额低于 10 万的项目	8,199.00	221.52	5,809.00				
合计	/	33,302.53	4,647.77	18,343.34	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

本持续督导期间，财务人员将募集资金专户中的发行费用 2,467.32 万元转入一般户，公司发现后第一时间将相关资金及利息转回募集资金专户。上述转出资金未影响募集资金的操作及使用，公司不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。

公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现其他违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

上海合晶无实际控制人。截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东 STIC 的持股数量为 319,624,122，报告期内，STIC 不存在减持，亦不存在质押、冻结的情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的直接持股及变动情况如下：

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘苏生	董事长	0	233,333	233,333	2020 年股票期权激励计划和

					2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
焦平海	董事	0	116,667	116,667	2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
郜中和	董事	0	66,667	66,667	2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
毛瑞源	董事	0	66,667	66,667	2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
廖琼	董事	0	0	0	-
余经纬	董事	0	0	0	-
邓泗堂	独立董事	0	0	0	-
彭协如	独立董事	0	0	0	-
徐征	独立董事	0	0	0	-
叶德昌	监事会主席	0	0	0	-
李建军	监事	0	0	0	-
何琳	职工监事	0	0	0	-
陈建纲	总经理、 核心技术人员	0	200,000	200,000	2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
庄子祊	董事会秘书	0	76,667	76,667	2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
管继孟	财务总监	0	50,000	50,000	2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
钟佑生	核心技术人员	0	100,000	100,000	2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
尚海波	核心技术人员	0	50,000	50,000	2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
吴泓明	核心技术人员	0	60,000	60,000	2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
高璇	核心技术人员	0	60,000	60,000	2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
林建亨	核心技术人员	0	30,000	30,000	2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权
邹崇生	核心技术人员	0	52,000	52,000	2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权、二级市场买入

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在质押、冻结及减持情况。

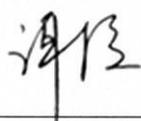
十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

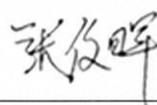
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司
2024 半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：



谢雯



张俊晖

